



【News Release】 インダストリー温度対応

NVMe SSD N600Si/N600Sc

ATP Electronics Inc.(以下ATP社)はPCIe NVMeの速度とパフォーマンスを3D NANDフラッシュ、大容量のトリプル・レベル・フラッシュ(TLC)、高性能8チャンネル・コントローラー、エンド・トゥー・エンドのデータ保護、画期的な電源管理、電力損失保護(PLP)テクノロジーにより統合させた、次世代のM.2 2280 NVMe SSDであるN600Si/N600Scをリリースしました。

当ページではこのNVMe SSD N600Si/N600Sc製品の特長をご紹介します。



NVMe SSD N600Si/N600Scの特長・概要

● 概要

- ・対応製品容量：120/240/480/960/1920 GB
- ・シーケンシャル・リード/ライト性能：3,420/3,050 MB/s max.
- ・耐久性：Up to 5,120 TB
- ・対応温度：I-Temp (N600Si) and C-Temp (N600Sc)
- ・エンド・トゥー・エンドのデータ保護、RAIDサポート

● 8チャンネルNAND性能

ATPのN600Si/N600Sc M.2 NVMe 2280 SSDは、8Gb/s PCIe Gen3 x4レーンの同時データフローと8つのNANDチャンネルを特長としています。この設計は、ハードウェアとソフトウェアの両方を最適化してPCIe 3.1及びNVMe 1.3 SSD仕様を最大限に活用し、高速で信頼性の高いストレージに対する業界のニーズに対応します。

● 包括的なデータ保護

エンド・トゥー・エンドのデータ・パス保護とSRAMエラー訂正コード(ECC)は、ホストシステムからSSDへのデータ転送パス全体またはその逆のエラー制御を提供し、データの整合性と信頼性の高いデータ転送を保証します。

● MCUベースのPLP設計

マイクロコントローラ(MCU)設計に基づく独自の電源管理および電源損失保護(PLP)メカニズムにより、信頼性を向上させます。ATPの第4世代PLPであるPowerProtector 4に統合されたMCU設計は、停電、グリッチ、および電源電流の問題が発生した場合に、デバイスの保護とデータの整合性を向上させます。ATP PowerProtector 4は、ハードウェアとファームウェアソリューションを組み合わせ、パワーアップ突入電流抑制や入力過電圧保護など、データとストレージデバイスの両方を保護します。データの整合性を向上させるために、入力電源ノイズ・デグリッチは、ノイズの多いホスト入力電圧や不安定なホスト入力電圧などの誤ったトリガーによって引き起こされる不正なキャッシュ・フラッシュを防止します。カスタマイズオプションが利用可能で、新しいMCUベースの設計により、PLPの機能を顧客固有の要件、アプリケーション固有のニーズ、またはユースケースに合わせてカスタマイズすることができます。

● LDPC+RAID エンジン・サポート

ATP N600Si/N600Sc NVMe SSDは、3D TLC NANDの耐久性とデータ保持を強化する内蔵プログラマブルRAIDエンジンを備えた独自の2KBコードワード低密度パリティチェック(LDPC)ECCを採用しています。RAIDサポートは冗長性と耐障害性を確保し、ドライブの故障時のデータ損失を防ぎます。

ATPについて

ATP Electronicsは、最高レベルのパフォーマンス、信頼性、耐久性を必要とする要求の厳しい産業用/車載アプリケーション向けの“インダストリアル・オンリー”NANDフラッシュ製品とDRAMモジュールのリーディング・プロバイダーです。25年以上に渡り真のメーカーであるATPは、製造プロセスの全ての段階を管理して品質と製品の長期供給性を確保し、コンポーネントから製品レベルまでの社内設計、テスト、及び調整を行っています。